開発仕様 / DEVELOPMENT SPECIFICATION

品番/Product Number LNJ414K82RA

種別 /TYPE	アンバー発光ダイオード / Amber Light Emitting Diode				
材質 /MATERIAL	InGaAIP				
用途 /APPLICATION	各種表示用 / Indicators				
外形 /OUTLINE	附図 / Attached				
絶対最大定格 ABSOLUTEMAXIMUMRATINGS	P *1 I _{FP} I _{FDC} V _R T _{op} , T _{stg} 消費電力 パルス順方向電流 順方向電流 逆方向電圧 動作周囲温度 保存温度 25 60 10 4 -30~+85 -40~+10 mW mA W °C °C				
試験条件 / CONDITION	T a = 2 5 ± 3 °C				

光学的·電気的特性 / Optical Electrical Specification

項 目 Item	項目 略号 条件 Item Symbol Condition		標準値 Type	許容値	I∕Limit	単位 Unit
	5,50.	Condition	1,00	Min.	Max.	Onic
順方向電圧降下 Forward Voltage	V _F	$I_F = 5$ mA DC	1.95		2.5	V
	V F	1F 0 IIIA DO	1.00		2.0	
逆方向漏洩電流 Reverse leakage Current	I _R	$V_R = 4 V$			100	μΑ
光度(軸上) *2	_					
Luminous Intensity	I o	$I_F = 5 \text{ mA DC}$	16	4	36.8	mcd
ト・ミナント発光波長	λа	$I_F = 5 \text{ mA DC}$	589	501	506	
Dominant Wavelength	λα	IF = 5 MA DC	509	581	596	nm
ピーク発光波長 *3 Peak Emission Wavelength	l λρ	$I_F = 5$ mA DC	595			nm
Feak Littlestoff vvavelengtif	Α β	1 TE O IIIA DO	000			nm
スペックトル半値幅	ا مما	$I_F = 5$ mA DC	15			
Spectral Line Half Width	Δ λ	1.5	10			nm

*1 l_{FP}の条件は、デューティー比 10%、パルス幅 1 ms.

The condition of pulse current I_{FP} is 1 ms pulse width, 10 % duty cycle.

DC=1 mA 以下および、印加時間 P w=1 ms、Duty=10% 未満の特別仕様並びに疑問点につき ましてはお問い合わせの程願います。

Please contact us for further information regarding special operating conditions such as

If: less than DC = 1 mA, Pulse condition: less than pulse width = 1 ms, duty = 10 %

*2 光度ランクについて

Rank classification of luminous intensity.

ランク Rank	光度 Luminous Intensity(mcd)
1	4.0 ~ 6.0
2	6.0 ~ 9.0
3	9.0 ~ 14.4
4	14.4 ~ 23.0
5	23.0 ~ 36.8

Rank classification of dominant wavelength

ランク Rank	波長 Dominant wavelength(nm)
Α	581 ~ 584
В	584 ~ 587
С	587 ~ 590
D	590 ~ 593
E	593 ~ 596

測定公差:±20%

Measurement tolerance: ±20%

ランク表示/Display decipher

測定公差: ±2nm

*3.波長ランクについて

Measurement tolerance: ±2nm

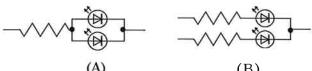
例/Example ₽3

光度ランク 3/Luminous intensity rank 3 波長ランク B/Dominant wavelength rank B

【注意/Note】

(1)静電気による製品破壊にご注意下さい。/ Beware of destruction by static electricity in handling the LED.

(2) 回路設計上の注意/Circuit to operate LED.



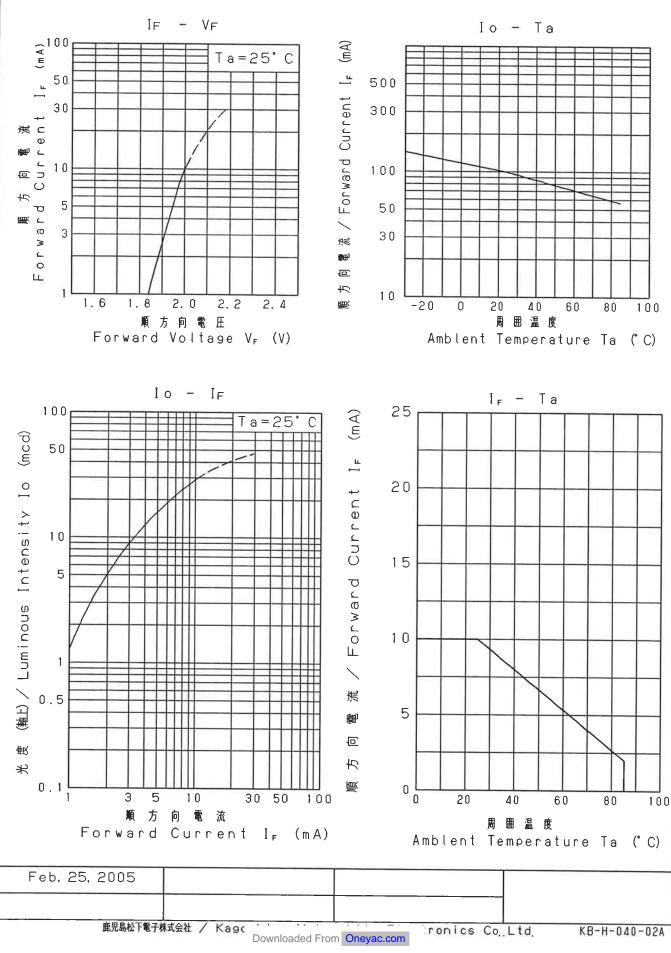
(A) の回路については VF の影響により光度バラツキが 懸念されますので(B)の回路を推奨致します。

(A)The difference of brightness between the LED could be found due to the V_F characteristics of each LED.

(2.2)	(B)	(B)Recommended circ		
Feb.25.2005				

鹿児島松下電子株式会社/ Kagoshima Matsushita Electronics Co., Ltd. KB-H-040-02A 開発仕様/Development Specification

品番/Product Number LNJ414K82RA

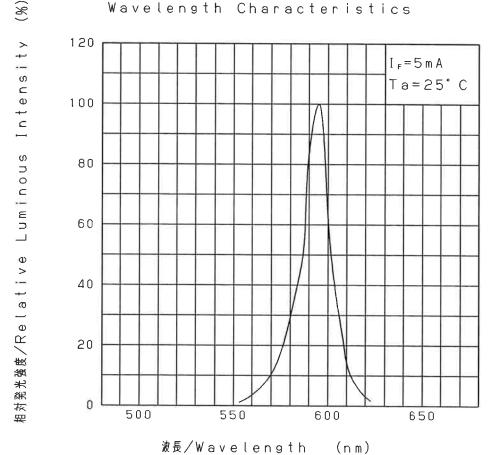


開発仕様/ Development Specification

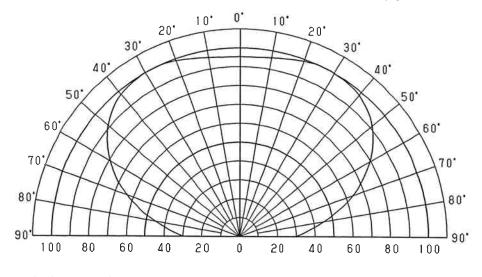
品番/Product Number LNJ414K82RA

相对発光強度 一 波長特性

Relative Luminous Intensity Wavelength Characteristics



指向特性 /Directive Characteristics

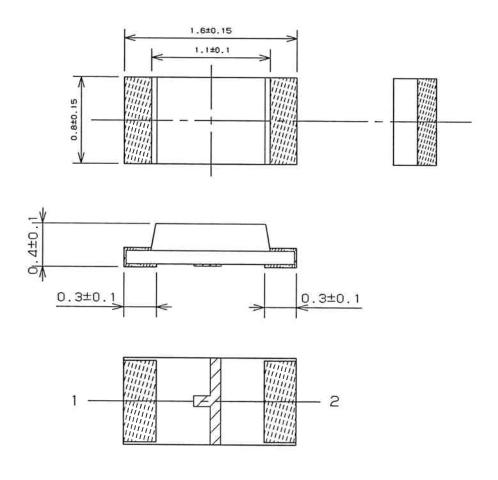


相対発光強度/Relative Luminous Intensity (%)

Feb. 25, 2005 **産児島松下電子株式会社 / Kag** Downloaded From **Oneyac.com**

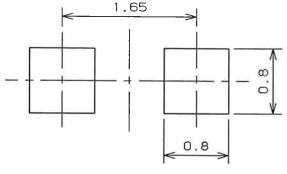
開発仕様 / Development Specification (OUTLINE)

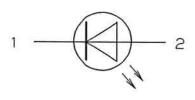
品番/Product Number LNJ414K82RA



推奨パターン / Recommended land layout

極性 / Polarity





1.カソート* 2.アノート* Cathode Anode

(注記 / NOTE)

- 1. Measurement of the package doesn't include electrode projection.
- 2.Unit:mm
- 1. パッケージ寸法については電極バリを含まない。
- 2. 単位: mm

Feb. 25, 2005

单击下面可查看定价,库存,交付和生命周期等信息

>>Panasonic(松下)